

請求の範囲

- [請求項1] 第1の表面及び前記第1の表面の反対側の第2の表面を有する基材層と、前記基材層の前記第2の表面上に設けられた、光硬化性粘着剤からなる粘着剤層と、前記粘着剤層の前記基材層とは反対側に設けられた接着剤層とを備えるダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムを準備する第1の工程と、
- 前記ダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムの前記基材層の前記第1の表面について、負荷長さ率 t_p を算出する第2の工程と、
- 前記負荷長さ率 t_p を指標として、ダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムの品質の良否を判定する第3の工程と、
- を備える、
- ダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムの品質管理方法。
- [請求項2] 前記負荷長さ率 t_p が、切断レベル50%における負荷長さ率 t_p (50%) である、
- 請求項1に記載のダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムの品質管理方法。
- [請求項3] 前記第3の工程は、前記負荷長さ率 t_p (50%) が15%以上であることを満たすか否かによって品質の良否を判定する工程である、
- 請求項2に記載のダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムの品質管理方法。
- [請求項4] 第1の表面及び前記第1の表面の反対側の第2の表面を有する基材層と、前記基材層の前記第2の表面上に設けられた、光硬化性粘着剤からなる粘着剤層と、前記粘着剤層の前記基材層とは反対側に設けられた接着剤層とを備えるダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムを準備する第1の工程と、
- 前記ダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムの前記基材層の前記第1の表面について、負荷長さ率 t_p を算出する第2の工程と、
- 前記負荷長さ率 t_p を指標として、ダイシング・ダイボンディングー

一体型フィルムの品質の良否を判定する第3の工程と、

前記第3の工程において、良と判定されたダイシング・ダイボンディング一体型フィルムを用いて半導体装置を製造する第4の工程と、
を備える、

半導体装置の製造方法。

[請求項5] 前記負荷長さ率 t_p が、切断レベル50%における負荷長さ率 t_p (50%) である、

請求項4に記載の半導体装置の製造方法。

[請求項6] 前記第3の工程は、前記負荷長さ率 t_p (50%) が15%以上であることを満たすか否かによって品質の良否を判定する工程である、

請求項5に記載の半導体装置の製造方法。

[請求項7] 第1の表面及び前記第1の表面の反対側の第2の表面を有する基材層と、

前記基材層の前記第2の表面上に設けられた、光硬化性粘着剤からなる粘着剤層と、

前記粘着剤層の前記基材層とは反対側に設けられた接着剤層と、
を備え、

前記基材層の前記第1の表面が、切断レベル50%における負荷長さ率 t_p (50%) が15%以上である、

ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム。